

Silicon Diode

BA172

50V / 150mA

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 74/75

BA 170 ... BA 172

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden
für allgemeine Anwendungen in der
Unterhaltungselektronik sowie als
Schaltdioden

Glasgehäuse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41880
Gewicht ca. 0,13 g
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden
diese Dioden gegurtet geliefert.
Näheres siehe unter „Gurtung“.



Grenzwerte

Sperrspannung			
BA 170	U_R	20	V
BA 171	U_R	30	V
BA 172	U_R	50	V
Richtstrom in Einwegschaltung mit R -Last bei $T_U = 25\text{ °C}$	I_D	150 1)	mA
Verlustleistung bei $T_U = 25\text{ °C}$	P_{tot}	300 1)	mW
Sperrschichttemperatur	T_J	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_S	-55...+150	°C

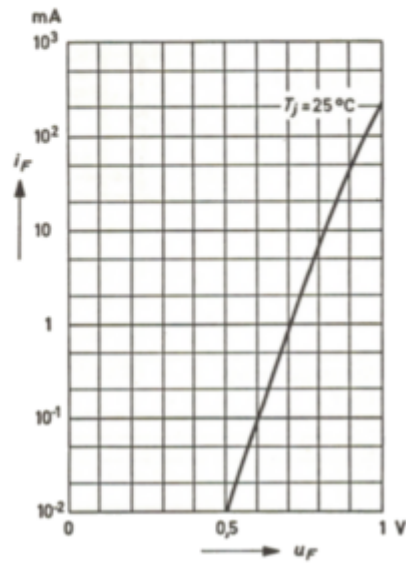
Kennwerte bei $T_U = 25\text{ °C}$

Durchlaßspannung bei $I_F = 80\text{ mA}$	U_F	<1	V
Sperrstrom			
BA 170 bei $U_R = 10\text{ V}$	I_R	<50	nA
BA 171 bei $U_R = 15\text{ V}$	I_R	<50	nA
BA 172 bei $U_R = 25\text{ V}$	I_R	<50	nA
Durchbruchspannung gemessen mit 5- μ A-Impulsen			
BA 170	$U_{(BR)R}$	>20	V
BA 171	$U_{(BR)R}$	>30	V
BA 172	$U_{(BR)R}$	>50	V
differentieller Durchlaßwiderstand bei $I_F = 100\text{ mA}$	r_f	0,5	Ω
Sperrverzögerungszeit beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	100	ns
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	R_{thU}	<0,41 1)	K/mW

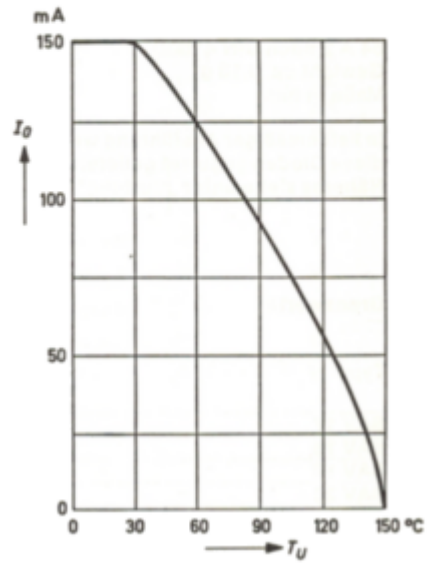
1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 4 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

BA 170 ... BA 172

Durchlaßkennlinie



zulässiger Richtstrom in Einwegschaltung mit R-Last in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (siehe Fußnote auf Seite 64)



zulässige Verlustleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (siehe Fußnote auf Seite 64)

